利用微波等离子体增强化学气相沉积法 定向生长纳米碳管的研究*

王 x^{1} ²) 李振华³) 竹川仁士²) 齐藤弥八²)

1(浙江大学物理系 杭州 310027)
2(日本三重大学工学部 津 514-8507)
3(浙江大学力学系 杭州 310027)
(2003年4月1日收到 2003年6月11日收到修改稿)

关键词:微波等离子体,纳米碳管

PACC: 6855, 8110, 8120

纳米碳管(carbon nanotube CNT)¹¹是由碳原子 排列成六角网面的石墨片卷曲而成的圆筒状中空 管,其直径为纳米量级,而长度一般为微米或毫米量 级[2],它具有长径比大,且顶端尖锐、导电性好、表面 化学稳定性好和机械强度高等优点.以纳米碳管作 为电子发射材料与目前使用的电子发射源相比,在 低电压下能发射电子 因而作为最有希望应用在场 发射显示(field emission display)上的新型电子发射 材料[3-7] 而备受研究人员的注目.纳米碳管作为电 场发射型显示器用的电子源,大面积且垂直于基板 方向的定向生长是非常必要的.我们利用微波等离 子体增强化学气相沉积(MPECVD)法^{8]}制备的纳米 碳管,与基板垂直排列、高密度且方向性好,作为电 子发射源是非常有前景的发射材料,另一方面 利用 MPECVD 法还可以制备出太阳能电池薄膜、三级管 用的非晶硅薄膜及微结晶硅薄膜。在这方面的研究 成果也正在逐步被应用.

化学气相沉积(CVD)法通常分为热CVD法、等 离子体CVD法和光CVD法^[9,10].等离子体CVD法 是当反应气体处于等离子体状态时,产生具有活性 的原子团或离子,在这种活性的气氛下所发生的化 学反应,即使在低温下也可在基板上成膜,因此,这 是一种比较实用的有效的制备薄膜方法.在等离子 体CVD法中,发生等离子体的方式通常有:直流电 弧放电、微波放电、高频放电等^{11-14]}.本文利用微波 放电法即 MPECVD 法,制备出纳米碳管薄膜,目的 就是为电子发射源提供一种新的材料.把制备出的 纳米碳管薄膜利用场发射扫描电子显微镜(SEM)对 其形貌进行了观察与分析,其模式图如图1所示.



图 1 MPECVD 装置模式图

利用 MPECVD 法制备纳米碳管薄膜所用微波 电源的频率为 2.45GHz、功率为 500W,石英反应室 样品台上的基板,使用 15mm×15mm、厚为 0.7mm 的 S(100)薄片,用真空镀膜方法在硅基板上镀覆上厚

^{*} 国家自然科学基金(批准号:60271009)及浙江省自然科学基金(批准号:501109)资助的课题.

度为 120nm 左右的铁膜. 在对石英反应室进行真空 排气后,打开微波电源,通入流量为 80sccm 氢气,使 之产生等离子体放电,对镀覆好铁膜的硅基板,利用 氢气等离子体进行清洗处理 10min,其压强控制在 225Pa,然后在氢气和甲烷混合气体的等离子体中生 长纳米碳管 10min,甲烷的流量为 20sccm,纳米碳管 生长时的压强控制在 250Pa,基板温度为 600℃. 生 长结束后,关闭反应气体,在真空中自然冷却 30min 后取出样品.可以看到在硅基板上定向生长一层黑 色的纳米碳管薄膜.

将生长好纳米碳管薄膜的硅基板切开,其断面 利用场发射 SEM(HITACHI S-4000)进行观察,其 SEM 图像如图 2 所示.从图 2 可以看到 纳米碳管全 部垂直于基板生长,且高密度整齐排列,长度均在 4.0µm 左右.断面处有微量凌乱的碳管,是由于切开 硅片时造成的.



图 2 断面处纳米碳管的 SEM 图像

将定向生长的纳米碳管制成样品,其透射电子显微镜(TEM)图像如图3所示.可以看出:纳米碳管中心部均空心,其外径在30—40nm之间,管径均匀,碳管顶端均有一催化剂颗粒.

在镀有铁金属催化剂薄膜的硅基板上,用氢气 等离子体清洗处理后,硅基板表面的 SEM 图像如图 4所示.从图4可以看出金属铁微粒子高密度整齐 排列.当通入甲烷气体时,在等离子体状态下,C的 粒子流在基板上施加负偏压电场的作用下,向基板 表面运动,在铁微粒子催化剂的表面生长出了大量 与基板垂直排列的纳米碳管,管径大多在30—40nm 之间.纳米碳管的定向生长与施加到基板上的负的 偏压电压有关,还与经氢气等离子体处理后所形成 的金属微粒子的直径和形成密度有关.这些问题有 待于进一步研究.



图 3 纳米碳管的 TEM 图像



图 4 氢气等离子处理后硅基板表面的 SEM 图像

- [1] Iijima S 1991 Nature 354 56
- [2] Pan Z W et al 1998 Nature 394 631
- [3] Saito Y et al 1997 Nature 389 554
- [4] Saito Y ,Mizushima R and Hata K 2002 Surf. Sci. 499 119
- [5] Fransen M J et al 1999 Appl. Surf. Sci. 146 312
- [6] Saito Y Mizushima R Kondo S and Maida M 2000 Japan. J. Appl. Phys. 39 4168
- [7] Saito Y et al 2002 Physica B 323 30

- [8] 佐藤英樹、 藤弥八 2001 第 62 回日本応用物理学會學術講 演會 13P-M-6 ,p579(in Japanese] 佐藤英树、齐藤弥八 2001 第 62 届日本应用物理学会学术讲演会 13P-M-6 ,第 579 页]
- [9] 田中一義 2001 カーボンナノチコプーナノテクノロジへの 挑戦 東京 :日本化學同人 (in Japanese) 田中一义 2001 纳米 碳管──向纳米器件的挑战(东京 :日本化学同人)]
- [10] Hu Y 2001 Acta Phys. Sin. 50 2452(in Chinese] 胡 颖 2001物 理学报 50 2452]
- [11] 高井治 2001 日本応用物理 70 1211 in Japanese] 高井治 2001 日本应用物理 70 1212]
- [12] Li Z H et al 2002 Chin. Phys. Lett. 19 91
- [13] Wang M et al 2000 Acta Phys. Sin. 49 1106 in Chinese I 王 森 等 2000 物理学报 49 1106]
- [14] Wang M and Li Z H 2001 Acta Phys. Sin. 50 790(in Chinese] 王 森、李振华 2001 物理学报 50 790]

Study on the definite direction growth of carbon nanotubes by the microwave plasma-enhanced chemical vapro phase deposition *

Wang Miao^{1,2,)} Li Zhen-Hua^{3,)} Takegawa Hitosi^{2,)} Saito Yahachi^{2,)}

¹⁾(Department of Physics ,Zhejiang University ,Hangzhou 310027 ,China)

²) (Department of Electrical and Electronic Engineering ,Mie University ,Tu Japan 514-8507)

³ (Department of Mechanics , Zhejiang University , Hangzhou 310027 , China)

(Received 1 April 2003 ; revised manuscript received 11 June 2003)

Abstract

Using the microwave plasma-enhanced chemical vapor phase deposition, in the gas mixture of the methane and hydrogen, the aligned growth of the carbon nanotubes was observed and analyzed with a scanning electron microscope. The carbon nanotubes have the tidy arrangement in the perpendicular direction on a solid substrate. Its length is the same as the uniform caliber. This kind of carbon nanotubes can be used as the potential electron source material.

Keywords : microwave plasma , carbon nanotubes PACC : 6855 , 8110 , 8120

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China Grant No. 60271009), and the Natural Science Foundation of Zhejiang Province, China Grant No. 501109).